



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GMBAV74

SWITCHING DIODE 開關二極管(BAV74)

■FEATURES 特點

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|-----------------------------|-------------|---------|
| Power dissipation 耗散功率 | $P_D(T_a=25^\circ\text{C})$ | 225 | mW |
| Forward Current 正向電流 | I_F | 200 | mA |
| Reverse Voltage 反向電壓 | V_R | 50 | V |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度 | T_J, T_{stg} | -55to+150°C | |

■DEVICE MARKING 打標

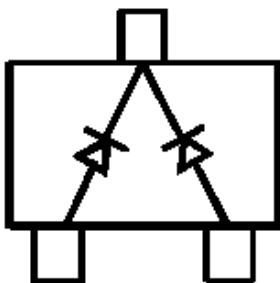
BAV74=JA

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊说明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|--|--------------|------------|------------|---------------|
| Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=5\mu\text{A}$) | $V_{(BR)}$ | 50 | — | V |
| Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=50\text{V}$) | I_R | — | 0.1 | μA |
| Forward Voltage 正向電壓 $I_F=100\text{mA}$ (Test Condition) | V_F | — | 1 | V |
| Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$) | C_D | — | 2 | pF |
| Reverse Recovery Time 反向恢復時間 | T_{rr} | — | 4 | nS |

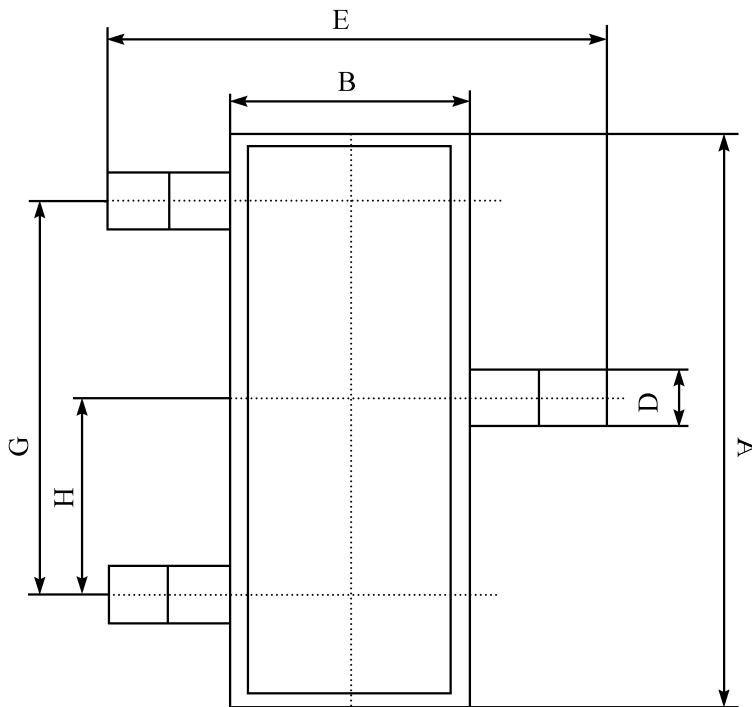
■SOT-23 内部结构





GMBAV74

■DIMENSION 外形封裝尺寸



| 序號 | 數值及公差 |
|----|-----------------|
| A | 2.90 ± 0.10 |
| B | 1.30 ± 0.10 |
| C | 1.00 ± 0.10 |
| D | 0.40 ± 0.10 |
| E | 2.40 ± 0.20 |
| G | 1.90 ± 0.10 |
| H | 0.95 ± 0.05 |
| J | 0.13 ± 0.05 |
| K | $0.00 - 0.10$ |
| M | ≥ 0.2 |
| N | 0.60 ± 0.10 |
| P | $7 \pm 2^\circ$ |

